



CONFÉDÉRATION SUISSE
INSTITUT FÉDÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

(11) **CH** **705 724 A1**

(51) Int. Cl.: **B81B** 3/00 (2006.01)
G04B 17/06 (2006.01)
G04D 3/00 (2006.01)
B81B 1/00 (2006.01)

Demande de brevet pour la Suisse et le Liechtenstein

Traité sur les brevets, du 22 décembre 1978, entre la Suisse et le Liechtenstein

(12) **DEMANDE DE BREVET**

(21) Numéro de la demande: 01765/11

(71) Requéant:
Sigatec SA, Route des Iles 20
1950 Sion (CH)

(22) Date de dépôt: 03.11.2011

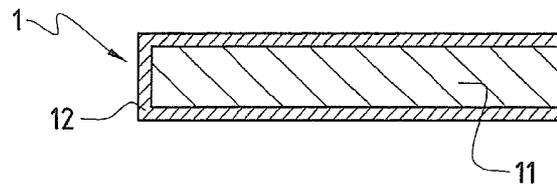
(72) Inventeur(s):
Marc-André Glassey, 1967 Bramois (CH)
Pierre Gygax, 2016 Cortaillod (CH)

(43) Demande publiée: 15.05.2013

(74) Mandataire:
BOVARD SA, Conseils en propriété intellectuelle
Optingenstrasse 16
3000 Berne 25 (CH)

(54) **Pièce de micromécanique, notamment pour l'horlogerie.**

(57) La présente invention se rapporte à une pièce de micromécanique (1), notamment pour l'horlogerie, comprenant une âme (11) au moins partiellement en un matériau semi-conducteur électrique et un revêtement (12) sur la surface de l'âme (11) en un matériau isolant électrique, dans laquelle le matériau semi-conducteur de l'âme (11) possède une conductivité électrique élevée et la surface de l'âme (11) est au moins sur une partie libérée du revêtement (12), de façon à permettre une décharge électrique entre l'âme (11) et un corps extérieur. Notamment, l'âme (11) de la pièce (1) peut être en silicium dopé ou soumis à une implantation ionique. En outre, l'invention se rapporte également à un procédé de fabrication de la pièce (1).



Description

Domaine technique

[0001] Cette demande se rapporte à une pièce de micromécanique, notamment pour l'horlogerie, comprenant une âme au moins partiellement en un matériau semi-conducteur électrique et un revêtement sur la surface de l'âme en un matériau isolant électrique.

Etat de la technique

[0002] De telles pièces de micromécanique sont déjà connues. Par exemple, la demande de brevet européen EP-A-2 215 531 montre un ressort spiral qui est fabriqué en silicium monocristallin avec la découpe cristallographique {1,1,1} et qui est par la suite revêtu d'une couche en oxyde de silicium pour obtenir une compensation thermique de l'ensemble balancier-spiral. En outre, le document EP-A-0 732 635 propose également de réaliser une pièce de micromécanique, p.ex. pour un mouvement horloger, en un premier matériau et de la revêtir par la suite par un deuxième matériau.

[0003] L'utilisation du silicium pour la réalisation des pièces de micromécaniques liées aux mouvements horlogères fait donc aujourd'hui partie des technologies standard.

[0004] Les pièces fabriquées en silicium (ou un autre matériau similaire) offrent plusieurs avantages par rapport aux pièces horlogères classiques qui sont typiquement fabriquées en un matériau métallique, tel que fer, laiton, cuivre, ou autre. Parmi ces avantages, on peut citer notamment une fabrication simplifiée des grandes séries ainsi que la possibilité de réaliser les pièces avec des structures très spécifiques. Egalement, la qualité des états de surface et de la précision de ces pièces est nettement supérieure comparée avec les pièces qui sont fabriquées de manière classique.

[0005] L'autre grand avantage de ce type de pièces de micromécanique est la possibilité de les revêtir des différents matériaux afin d'améliorer les propriétés tribologiques (comme p.ex. dans le document précité EP-A-0 732 635) ou pour réaliser la compensation thermique (cf. le document EP-A-2 215 531). Dans ce sens, il est notamment possible d'utiliser un revêtement en oxyde de silicium et/ou en diamant de façon à réduire ou même complètement éliminer la nécessité de lubrifier les pièces.

[0006] Habituellement, les couches recouvrant le silicium sont en matériau isolant électrique. Les isolants électriques sont des matériaux qui n'ont pas (ou qui n'ont que très peu) de charges libres parce que la plupart des charges électriques sont fermement piégées dans le matériau. Par conséquent, un matériau isolant qui est soumis à l'action d'un champ électromagnétique ne conduira pas d'électricité, contrairement à un matériau conducteur.

[0007] Grâce à ce fait, les matériaux isolants se chargent d'électricité statique de manière spontanée et ne s'en libèrent que difficilement. Cet effet est schématiquement représenté dans la fig. 1 qui illustre une pièce de micromécanique de l'état de la technique avec quelques charges électriques réparties sur la surface de la pièce. Dans la pièce qui est illustrée dans la fig.1, l'âme de la pièce est fabriquée en silicium et recouverte d'un revêtement en oxyde de silicium. Cependant, le même effet électrostatique se produit avec tout autre revêtement en un matériau isolant.

[0008] La présence d'électricité statique sur la surface des pièces crée des forces entre les pièces qui empêchent un fonctionnement optimal de la montre. En outre, les charges électrostatiques sur la surface de la pièce attirent les particules de poussière qui peuvent dégrader le fonctionnement des pièces. Finalement, une grande accumulation des charges peut provoquer des décharges (étincelles) violentes qui peuvent même résulter en une détérioration physique des pièces.

Exposé sommaire de l'invention

[0009] La présente invention a donc pour objet de proposer une pièce de micromécanique qui ne présente pas ces désavantages de pièces connues et qui est en outre particulièrement convenable pour être utilisée dans le domaine d'horlogerie. De manière spécifique, l'objet de la présente invention est de proposer une pièce de micromécanique, notamment pour l'horlogerie, qui permet une décharge facile des charges électrostatiques de sa surface.

[0010] A cet effet, l'invention a pour objet selon un premier aspect une pièce de micromécanique, notamment pour l'horlogerie, comprenant une âme au moins partiellement en un matériau semi-conducteur électrique et un revêtement sur la surface de l'âme en un matériau isolant électrique, où le matériau semi-conducteur de l'âme possède une conductivité électrique élevée et que la surface de l'âme est au moins sur une partie libérée du revêtement, de façon à permettre une décharge électrique entre l'âme et un corps extérieur.

[0011] L'avantage de cette invention réside particulièrement dans le fait que l'âme de la pièce est utilisée pour la décharge électrique. Grâce à une conductivité électrique élevée de l'âme, les charges électriques de la surface peuvent traverser le revêtement pour atteindre le matériau semi-conducteur. Comme au moins une partie de la surface de l'âme dans la pièce selon la présente invention n'est pas recouverte du revêtement isolateur, les charges électriques peuvent traverser l'âme pour se décharger vers un corps extérieur. De cette manière, tous les problèmes liés à l'électricité statique sur la surface des pièces sont éliminés d'une manière efficace.

[0012] Selon un mode de réalisation de l'invention, la conductivité électrique du matériau semi-conducteur de l'âme est augmentée par un dopage et/ou par une implantation ionique. Le dopage d'un matériau semi-conducteur (tel que silicium)

est la technique qui permet d'ajouter des impuretés en petites quantités au semi-conducteur afin de modifier ses propriétés concernant la conductivité électrique. Typiquement, le dopage est réalisé dans un four par diffusion à partir d'un gaz vecteur. L'implantation ionique est une autre variante de la technique de dopage et elle consiste notamment à accélérer des impuretés ionisées avec un champ électrique, afin de leur conférer l'énergie nécessaire pour rentrer dans le matériau à doper.

[0013] Ce mode de réalisation de l'invention a notamment l'avantage qu'un matériau fabriqué à l'aide des techniques connues peut être utilisé pour obtenir les résultats souhaités. De même, un matériau semi-conducteur dopé est généralement stable dans le temps et ne perd donc pas ses propriétés de conductivité.

[0014] De manière notable, l'âme peut comprendre au moins une couche intérieure et une couche extérieure, la conductivité électrique de la couche extérieure étant plus élevée que la conductivité électrique de la couche intérieure. L'avantage de ce mode de réalisation de l'invention, parmi d'autres choses, réside dans le fait que juste la partie extérieure de l'âme de la pièce doit être soumise à un traitement afin d'augmenter sa conductivité électrique. Comme c'est cette partie extérieure de l'âme qui reste en contact avec le revêtement extérieur, les charges électriques peuvent néanmoins traverser l'âme pour être déchargées par un corps extérieur.

[0015] Selon un autre mode de la réalisation de la présente invention, un deuxième revêtement en un matériau conducteur électrique est prévu entre la surface de l'âme et le revêtement en un matériau isolant électrique. En particulier, ce deuxième revêtement peut être composé d'un matériau métallique, tel que chrome, vanadium ou titane. Bien sûr, d'autres métaux ou alliages de métaux sont également possibles. Cet autre mode de réalisation de la présente invention a l'avantage, parmi d'autres choses, que la fabrication d'une telle pièce peut être simplifiée. Concrètement, l'âme de la pièce peut être gravée dans une plaque du silicium selon les procédés connus, pour être revêtue d'une couche en métal par un procédé approprié. A la fin, un revêtement final en un matériau isolant peut être déposé sur la couche métallique.

[0016] De manière notable, l'âme de la pièce est au moins partiellement composée du silicium. Les avantages du silicium sont déjà mentionnés, mais on peut rappeler qu'il est très avantageux pour la production des pièces horlogères grâce à ses propriétés mécaniques, physiques et tribologiques. Egalement, le revêtement des pièces peut notablement être composé de diamant et/ou d'oxyde de silicium qui est également de très bonnes propriétés thermiques et tribologiques.

[0017] Selon un autre mode de réalisation de la présente invention, un élément connecteur est prévu entre l'âme et le corps extérieur. L'avantage de cet autre mode de réalisation de l'invention est la possibilité de connecter la pièce à un corps extérieur afin de favoriser la décharge. Typiquement, la pièce peut être reliée au mouvement horloger et ainsi à la masse.

[0018] L'élément connecteur peut notablement être une colle conductrice électrique. En particulier, une colle conductrice permet d'utiliser un seul moyen pour réaliser à la fois une connexion mécanique et une connexion électrique entre la pièce et le corps extérieur. Comme toutes les pièces dans un mouvement horloger sont reliées entre elles, l'utilisation d'une colle conductrice pour la fixation des pièces garantit qu'aucune mesure supplémentaire n'est nécessaire pour permettre la décharge de la pièce.

[0019] La pièce selon la présente invention peut notamment être un spiral horloger, destiné à être utilisé avec un balancier dans un ensemble balancier-spiral dans un mouvement horloger. Un fonctionnement propre de l'ensemble balancier-spiral est essentiel pour une bonne précision de la montre. Une élimination complète des problèmes liés à l'électricité statique est donc très particulièrement importante pour un spiral horloger. Néanmoins, d'autres pièces de micromécanique, typiques d'un mouvement mécanique, peuvent aussi bénéficier de ce système de décharge par l'âme. Parmi les pièces susceptibles d'en profiter, on peut notamment citer l'ancre et la roue d'échappement, ainsi que des roues d'entraînement.

[0020] De manière notable, dans une pièce de micromécanique selon un mode de réalisation de la présente invention, l'électricité statique déchargée par l'âme peut être acheminée sur un élément voisin de la chaîne cinématique par une couche conductrice. En particulier, ceci pourrait p.ex. s'appliquer à un mobile dans le rouage de finissage qui décharge l'électricité statique par l'âme sur l'axe et la transmet par la suite sur le mobile suivant. L'avantage de ce mode de réalisation réside notamment dans le fait que toute pièce dans un mouvement mécanique peut être déchargée, même si elle n'est pas en contact direct avec le châssis et/ou le boîtier de la montre.

[0021] A cet endroit, nous aimerions mentionner que la présente invention se rapporte également à un procédé de fabrication d'une pièce de micromécanique, ce procédé comprenant les étapes suivantes:

- graver une âme de la pièce de micromécanique un matériau semiconducteur électrique possédant une conductivité électrique élevée;
- déposer au moins une couche de revêtement en un matériau isolant électrique sur la totalité de la surface de l'âme, et
- enlever le revêtement sur au moins une partie de la surface de l'âme de façon à libérer l'âme et de façon à permettre une décharge électrique entre l'âme et un corps extérieur.

[0022] L'avantage de cet autre aspect de la présente invention réside particulièrement dans le fait que la pièce peut être fabriquée d'une manière simple et économique. Les procédés classiques et bien connus peuvent être utilisés, p.ex. la gravure ionique réactive profonde dans une plaque de silicium afin de réaliser l'âme et la déposition d'oxyde de silicium par oxydation thermique, par un dépôt chimique en phase vapeur assisté par du plasma (PECVD) ou déposition du diamant afin de réaliser le revêtement de la surface.

Brève description des dessins

[0023] L'invention sera bien comprise à la lecture de la description ci-après faite à titre d'exemple non limitatif, en regardant les dessins ci-annexés qui représentent schématiquement:

- fig. 1, une vue de coupe d'une pièce de micromécanique selon une solution connue de l'état de la technique;
- fig. 2, une vue de coupe d'une pièce de micromécanique selon un premier mode de réalisation de la présente invention;
- fig. 3, une vue en perspective de la pièce de micromécanique selon le premier mode de réalisation de la présente invention, tel que représenté dans la figure 2;
- fig. 4, une vue de coupe d'une pièce de micromécanique selon un deuxième mode de réalisation de la présente invention;
- fig. 5, une vue de coupe d'une pièce de micromécanique selon un troisième mode de réalisation de la présente invention; et
- fig. 6, une vue de coupe d'une pièce de micromécanique selon un quatrième mode de réalisation de la présente invention.

Description détaillée de l'invention

[0024] La description suivante, en se reportant aux dessins, explique plus en détail quelques modes de réalisation non limitatifs d'une pièce de micromécanique et de son procédé de fabrication selon la présente invention.

[0025] Les mêmes numéros de référence dans les différentes figures indiquent les mêmes éléments, sauf si le contraire est explicitement mentionné.

[0026] Fig. 1 illustre une vue de coupe d'une pièce de micromécanique connue de l'état de la technique. Cette pièce comporte une âme (partie principale) en silicium Si dont toute la surface est revêtue d'une couche de diamant, oxyde de silicium ou un autre matériau isolant. Au lieu de silicium, l'âme de la pièce peut également être réalisée en un autre matériau isolant ou même être créée par une combinaison des matériaux. L'âme de la pièce est typiquement obtenue par gravure ionique réactive profonde, même si d'autres procédés de fabrication peuvent être utilisés.

[0027] Comme déjà mentionné, les isolants électriques (tels que le diamant ou l'oxyde de silicium) sont des matériaux qui ont peu de charges libres et ils se chargent donc d'électricité statique de manière spontanée. Dans la fig. 1, les charges accumulées sur la surface de la pièce sont schématiquement illustrées par des petits ronds symbolisant les électrons. Cette électricité statique sur des pièces a des effets très désavantageux sur leurs performances.

[0028] Pour palier à ces inconvénients des pièces de micromécanique actuelles, la présente invention propose par exemple une pièce de micromécanique telle que représentée dans la fig. 2. La pièce 1 comporte également une âme 11 et un revêtement 12 sur la surface de l'âme 11. L'âme 11 est réalisée en un matériau semi-conducteur, tel que silicium monocristallin ou polycristallin. Bien entendu, d'autres matériaux avec les propriétés de semi-conducteurs sont tout à fait possibles. L'âme 11 peut être gravée dans une plaque de matériau semi-conducteur à l'aide des procédés connus, tels que gravure ionique réactive profonde. D'autres procédés peuvent évidemment être appliqués. La surface de l'âme 11 de la pièce 1 est revêtue d'une couche d'un matériau isolant électrique 12, tel que l'oxyde de silicium (SiO₂) ou le diamant. De nouveau, d'autres matériaux isolants peuvent être utilisés.

[0029] Contrairement à une pièce connue de l'état de la technique, l'âme 11 de la pièce de micromécanique 1 selon la présente invention est réalisée en un matériau semi-conducteur ayant une conductivité électrique élevée. La conductivité électrique améliorée du matériau semi-conducteur peut être atteinte grâce à des différents moyens, illustrés plus en détail ultérieurement. Une partie de la surface de l'âme 11 de la pièce de micromécanique 1 dans la fig. 2 (la partie à droite de la figure) est libérée du revêtement 12. La fig. 3 explique la pièce 1 dans une vue en perspective. Dans cette fig. 3, on retrouve l'âme 11 de la pièce 1 et son revêtement 12. Il est facilement visible qu'une partie de l'âme 11 n'est pas recouverte de la couche 12. Parce fait, il est possible de réaliser une connexion mécanique et électrique entre l'âme 11 et un corps extérieur.

[0030] Typiquement, une pièce de micromécanique 1 telle que représentée dans la fig. 3 peut être un spiral horloger, destiné à être utilisé dans un mouvement horloger avec un balancier pour réaliser l'ensemble balancier-spiral qui détermine la marche de la montre. L'âme 11 du spiral 1 peut donc être ouverte (non recouverte du revêtement 12) à son bout extérieur qui sert notamment de connexion du spiral à l'élément appelé «coq». De cette façon, l'âme 11 du spiral 1 est reliée au mouvement et permet ainsi un dégagement simple des charges électriques statiques de la surface du spiral 1. Bien entendu, l'exemple des spiraux horlogers n'est aucunement limitatif et il est évident que d'autres pièces horlogères ou non-horlogères peuvent être réalisées de la même manière.

[0031] Grâce à une conductivité électrique élevée de l'âme 11 et le manque de revêtement 12 sur une certaine partie de la surface de l'âme 11, les charges électriques qui s'accumulent sur la surface de la pièce 1 peuvent facilement traverser le

revêtement 12 et se décharger à travers l'âme 11 et le corps extérieur. De cette façon, l'évacuation de l'électricité statique est directe et facile.

[0032] Afin d'obtenir une conductivité électrique améliorée dans l'âme 11, il est possible de procéder à un dopage du matériau semi-conducteur. Le dopage des semi-conducteurs permet concrètement d'ajouter des impuretés en petites quantités avec le but de modifier la conductivité électrique. Essentiellement, un matériau semi-conducteur ne conduit pas d'électricité. En effet, toutes les charges électriques dans un semi-conducteur sont typiquement engagées dans les liaisons covalentes et n'arrivent pas à atteindre l'énergie qui est nécessaire afin de passer dans l'état libre. Par le dopage, les atomes d'un autre matériau sont introduits dans la matrice du matériau semi-conducteur. Ces atomes, ayant un surplus ou un déficit d'électrons créent un déséquilibre énergétique qui rend le semi-conducteur capable de conduction électrique.

[0033] Il existe essentiellement deux types de dopage, à savoir le dopage de type N, qui consiste à produire un excès d'électrons, qui sont négativement chargés (d'où le nom), ainsi que le dopage de type P, qui consiste à produire une carence en électrons, donc un excès de trous, considérés comme positivement chargés.

[0034] Différentes techniques industrielles de dopage sont connues et utilisées à ce jour, notamment le dopage par diffusion (où les atomes des impuretés sont diffusés dans le semi-conducteur à partir d'un gaz vecteur), le dopage par transmutation nucléaire (où les atomes de silicium sont transformés par le procédé d'absorption de neutrons en un atome de phosphore) ou bien le dopage par implantation ionique (où les atomes des impuretés sont accélérés pour s'écraser contre le semi-conducteur et pour le pénétrer grâce à un champ magnétique). Bien entendu, la quantité des impuretés (et donc le niveau de dopage du semi-conducteur) peut être variée en fonction des besoins concrets. Un haut dopage est avantageux pour favoriser la décharge de l'électricité statique, mais le niveau de dopage peut aussi être baissé dans certaines situations qui requièrent une conductivité moins prononcée.

[0035] La pièce de micromécanique 1 dans la fig. 4 illustre un autre mode de réalisation de la présente invention. Cette pièce 1 comprend également une âme 11 en un matériau semi-conducteur (p.ex. silicium) et un revêtement 12 sur une partie de la surface de l'âme 11. Cependant, la pièce 1 est maintenant reliée à un corps extérieur 2 (p.ex. le «coq» du pont de balancier comme mentionné plus haut) par un élément connecteur 3. Cet élément connecteur 3 sert à assurer à la fois une liaison mécanique entre la pièce 2 et le corps extérieur 3 et une liaison électrique qui permet la décharge de l'électricité statique.

[0036] La fig. 4 peut aussi représenter la coupe d'une ancre ou d'une roue d'échappement où la position 2 représente l'axe.

[0037] L'élément connecteur 3 peut notamment être une colle conductrice électrique. Ce type de colles (également nommées «ECA» qui est un acronyme de l'anglais «Electrically Conductive Adhesive») possède à la fois la propriété de fixation mécanique (comme toutes les colles standard), mais permet également un transfert des charges électriques. Parmi les plus utilisées, on trouve à ce jour les polymères conducteurs électriques ou polymères conducteurs intrinsèques (PCI). Des pâtes conductrices pourraient également être utilisées dans certaines applications (comme p.ex. pour relier l'axe d'un mobile à la roue correspondante).

[0038] Bien entendu, d'autres éléments connecteurs 3 sont également possibles pour assurer une connexion électrique entre la pièce 1 et le corps extérieur 2, y compris notamment des éléments qui assurent la liaison entre la pièce 1 et le corps extérieur 2 de manière purement mécanique (p.ex. une liaison par brasage, rivetage, soudage, etc.). De même, il est aussi imaginable d'obtenir la liaison électrique entre la pièce de micromécanique 1 et le corps extérieur 2 par un contact direct entre la partie de l'âme 11 libérée du revêtement 12 et un segment approprié du corps 2. De préférence, une telle connexion devrait être protégée par un moyen approprié pour empêcher une oxydation non souhaitée du matériau semi-conducteur (p.ex. silicium). Une protection de la partie non-revêtue de l'âme 11 est importante de manière générale afin d'éviter la composition d'une couche d'oxyde natif qui rendrait difficile (ou même empêcherait complètement) le passage des charges électriques.

[0039] Nous insistons à cet endroit également sur le fait que la pièce 1 peut aussi être reliée de manière électrique à un corps extérieur afin de permettre la décharge de l'électricité statique par un contact passager entre une partie libérée de l'âme 11 et une surface appropriée d'un corps extérieur 2. Typiquement, une telle connexion électrique transitoire pourrait être réalisée entre les palettes d'une ancre et les dents de la roue correspondante. Dans ce sens, la décharge électrique de l'ancre pourrait se produire lors de chaque nouveau contact avec la roue d'échappement.

[0040] Les fig. 5 et 6 montrent deux autres modes de réalisation de cette invention. Concrètement, la pièce de micromécanique 1 dans la fig. 5 a une âme 11 qui comprend une couche intérieure 11a et une couche extérieure 11b, avec les conductivités électriques différentes. En particulier, les matériaux pour ces deux couches 11a, 11b peuvent être choisis de façon à ce que la conductivité électrique de la couche extérieure 11 b soit plus élevée que la conductivité électrique de la couche intérieure 11b. Cet effet peut p.ex. être obtenu par des dopages différents des différentes couches du silicium ou par la création d'une structure sandwich à partir de deux plaques de silicium avec les propriétés conductrices différentes.

[0041] D'un autre côté, dans la fig. 6, un deuxième revêtement 13 en un matériau conducteur électrique est prévu entre la surface de l'âme 11 et le premier revêtement 12 du matériau isolant électrique. Ce deuxième revêtement 13 peut surtout être composé d'un matériau métallique, tel que chrome ou titane, mais il est tout à fait possible de réaliser ce deuxième revêtement 13 en un non-métal. Dans ce cas, il est bien entendu très important de choisir les matériaux pour les premier 12 et deuxième 13 revêtement de façon à obtenir une bonne adhérence des matériaux. Notamment, un revêtement 12

extérieur en diamant est très adapté à être utilisé avec une couche intermédiaire 13, étant donné qu'il a une bonne adhérence sur les surfaces métalliques.

[0042] Pour résumer, la présente invention se rapporte essentiellement à une pièce 1 de micromécanique qui comprend une âme 11 fabriquée en un matériau semi-conducteur et un revêtement 12 qui ne couvre la surface de l'âme 11 que partiellement. La partie libre de l'âme 11 est connectée électriquement à un corps extérieur pour permettre l'évacuation des charges électriques accumulées sur la surface de la pièce 1 par l'âme 11 dont la conductivité, à ce titre, a été augmentée par un dopage du matériau semi-conducteur ou l'application d'une couche conductrice (p.ex. métallique) entre la surface de l'âme 11 et le revêtement isolant 12.

[0043] Dans le procédé de fabrication d'une pièce de micromécanique 1 selon la présente invention, on grave une âme 11 dans une plaque d'un matériau semi-conducteur électrique (p.ex. silicium), possédant une conductivité électrique élevée. Par la suite, on dépose d'abord au moins une couche de revêtement 12 en un matériau isolant électrique sur la totalité de la surface de l'âme 11 et on enlève finalement ce revêtement 12 sur au moins une partie de la surface de l'âme 11. De cette manière, l'âme 11 est libérée sur au moins une partie et une décharge électrique entre l'âme 11 et un corps 2 extérieur peut alors être réalisée. Si nécessaire (comme explicité en connexion avec le mode de réalisation de l'invention dans la fig. 6), un deuxième revêtement 13 en un matériau conducteur électrique peut être déposé sur l'âme 11 avant de déposer le revêtement 12 isolant.

[0044] La libération de l'âme 11 peut être atteinte à l'aide de différents moyens, notamment:

- On peut briser l'âme 11 (donc le silicium) et sa couche isolante 12 de manière mécanique. Par exemple dans le cas d'un spiral horloger, on peut imaginer briser le spiral juste après le point de pitonnage;
- On peut briser l'âme 11 et sa couche isolante 12 par le biais d'une attache qui relie la pièce 1 au wafer. Une attache est un élément qui relie le composant (la pièce 1) au reste de la plaque du silicium dans laquelle on grave les pièces 1. Normalement, il s'agit d'une section très fine qu'on brise avant de détacher les pièces 1 du wafer. De cette manière, la séparation physique des pièces 1 du wafer favorise automatiquement l'exposition d'une partie de l'âme 11;
- On peut enlever la partie isolante 12 de la pièce 1 sur des pièces 1 fabriquées par un usinage mécanique (p.ex. le meulage); et
- on peut enlever le revêtement isolant 12 par un enlèvement chimique (p.ex. HF).

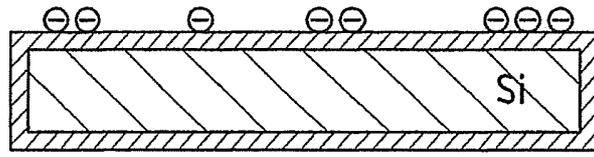
[0045] Dans ce qui précède, l'invention a été décrite d'abord en termes généraux et ensuite sous forme d'une explication de réalisations pratiques. Bien entendu, l'invention n'est pas limitée à la description de modes de mise en œuvre; il va de soi que de nombreuses variations et modifications peuvent être apportées sans que l'étendue de l'invention qui est définie par le contenu des revendications, ne soit quittée.

Revendications

1. Pièce de micromécanique (1), notamment pour l'horlogerie, comprenant une âme (11) au moins partiellement en un matériau semi-conducteur électrique et un revêtement (12) sur la surface de l'âme (11) en un matériau isolant électrique, caractérisée en ce que le matériau semi-conducteur de l'âme (11) possède une conductivité électrique élevée et que la surface de l'âme (11) est au moins sur une partie libérée du revêtement (12), de façon à permettre une décharge électrique entre l'âme (11) et un corps (2) extérieur.
2. Pièce de micromécanique (1) selon la revendication 1, caractérisée en ce que la conductivité électrique du matériau semi-conducteur de l'âme (11) est augmentée par un dopage et/ou par une implantation ionique.
3. Pièce de micromécanique (1) selon les revendications 1 ou 2, caractérisée en ce que l'âme (11) comprend au moins une couche intérieure (11a) et une couche extérieure (11b), la conductivité électrique de la couche extérieure (11b) étant plus élevée que la conductivité électrique de la couche intérieure (11a).
4. Pièce de micromécanique (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisée en ce qu'un deuxième revêtement (13) en un matériau conducteur électrique est prévu entre la surface de l'âme (11) et le revêtement (12) en un matériau isolant électrique.
5. Pièce de micromécanique (1) selon la revendication 4, caractérisée en ce que le deuxième revêtement (13) est composée d'un matériau métallique, tel que chrome, vanadium ou titane.
6. Pièce de micromécanique (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisée en ce que l'âme (11) est au moins partiellement composée du silicium.
7. Pièce de micromécanique (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisée en ce que le revêtement (12) est composé de diamant et/ou d'oxyde de silicium.
8. Pièce de micromécanique (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisée en ce qu'un élément connecteur (3) est prévu entre l'âme (11) et le corps extérieur (2).
9. Pièce de micromécanique (1) selon la revendication 8, caractérisée en ce que l'élément connecteur (3) est une colle conductrice électrique.

CH 705 724 A1

10. Pièce de micromécanique (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisée en ce que la pièce (1) est un spiral horloger, destiné à être utilisé avec un balancier dans un ensemble balancier-spiral, une ancre, roue d'ancre ou un mobile d'engrenage.
11. Pièce de micromécanique (1) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que l'électricité statique déchargée par l'âme (11) peut être acheminée sur un élément voisin de la chaîne cinématique par une couche conductrice.
12. Procédé de fabrication d'une pièce de micromécanique (1), caractérisé en ce que le procédé comprend les étapes suivantes:
 - graver une âme (11) de la pièce de micromécanique (1) un matériau semi-conducteur électrique possédant une conductivité électrique élevée;
 - déposer au moins une couche de revêtement (12) en un matériau isolant électrique sur la totalité de la surface de l'âme (11), et
 - enlever le revêtement (12) sur au moins une partie de la surface de l'âme (11) de façon à libérer l'âme (11) et de façon à permettre une décharge électrique entre l'âme (11) et un corps (2) extérieur.
13. Procédé de fabrication selon la revendication 12, dans lequel un deuxième revêtement (13) en un matériau conducteur électrique est déposé sur l'âme (11) avant de déposer le revêtement (12) en un matériau isolant électrique.
14. Procédé de fabrication selon les revendications 12 ou 13, dans lequel l'âme (11) est au moins partiellement fabriquée en silicium et dans lequel la gravure de l'âme (11) est effectuée par gravure ionique réactive profonde.
15. Procédé de fabrication selon l'une quelconque des revendications 12 à 14, dans lequel le revêtement (12) est en diamant et/ou en oxyde de silicium et dans lequel le revêtement est obtenu par oxydation thermique ou par dépôt chimique en phase vapeur assisté par du plasma.
16. Procédé de fabrication selon l'une quelconque des revendications 12 à 15, dans lequel le deuxième revêtement (13) est en métal tel que chrome, vanadium ou titane.



ETAT DE LA TECHNIQUE

FIG. 1

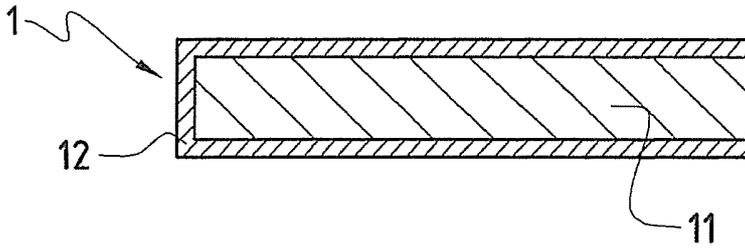


FIG. 2

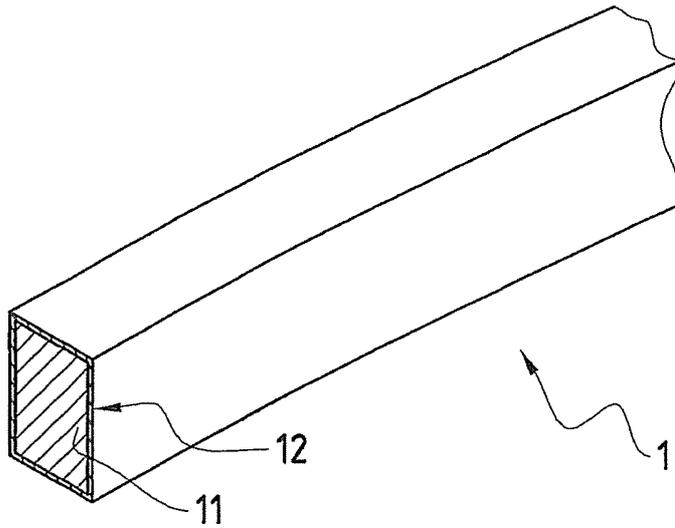


FIG. 3

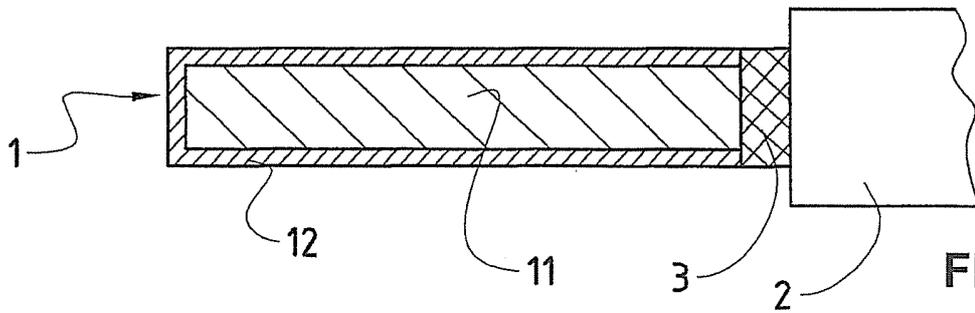
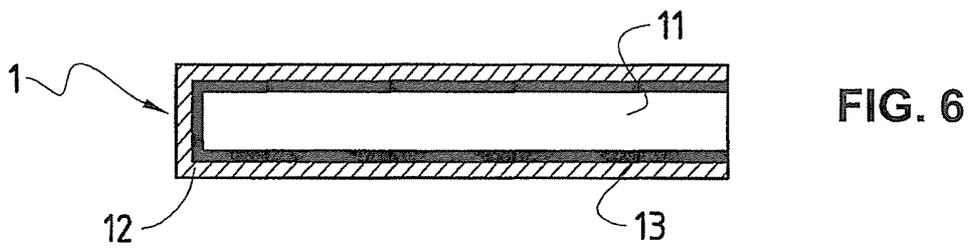
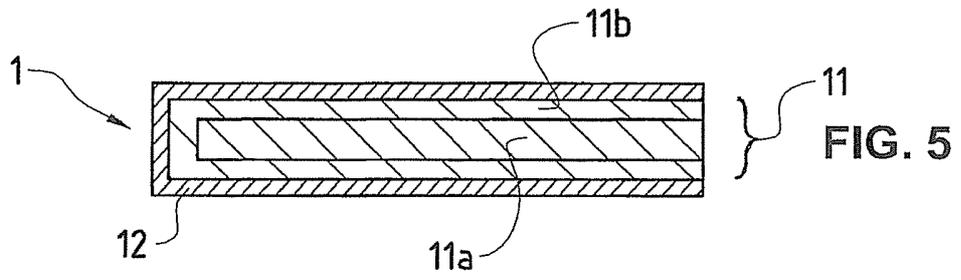


FIG. 4



TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

RAPPORT DE RECHERCHE DE TYPE INTERNATIONAL

IDENTIFICATION DE LA DEMANDE INTERNATIONALE		COTE DU DOSSIER DU DEPOSANT OU DU MANDATAIRE	
		162399.1/TK/lm	
Demande nationale n°		Date du dépôt	
1765/2011		03-11-2011	
Pays du dépôt		Date de priorité revendiquée	
Déposant (Nom)			
Sigatec SA			
Date de la requête d'une recherche de type international		Numéro donné par l'administration chargée de la recherche internationale à la requête d'une recherche de type international	
07-02-2012		SN 57636	
I. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE (en cas de plusieurs symboles de la classification, les indiquer tous)			
Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB			
B81B3/00		G04B17/06	
II. DOMAINES RECHERCHES			
Documentation minimale consultée			
Système de classification		Symboles de la classification	
IPC.8		B81B G04B C23C G04D	
Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents font partie des domaines consultés			
III. <input type="checkbox"/> IT A ETE ESTIME QUE CERTAINES REVENDICATIONS NE POUVAIENT FAIRE L'OBJET D'UNE RECHERCHE (Observations sur la feuille supplémentaire)			
IV. <input type="checkbox"/> ABSENCE D'UNITE DE L'INVENTION (Observations sur la feuille supplémentaire)			

Form PCT/ISA 201 A (11/2000)

RAPPORT DE RECHERCHE DE TYPE INTERNATIONAL

Demande de recherche No

CH 17652011

<p>A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE INV. B81B3/06 G04B17/06 ADD.</p>	
<p>Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB</p>	
<p>B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement) B81B G04B C23C G04D</p>	
<p>Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche</p>	
<p>Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés) EPO-internal, INSPEC, WPI Data</p>	
<p>C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS</p>	
<p>Catégorie *</p>	<p>Documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents</p>
<p>X</p>	<p>EP 2 236 455 A1 (GFD GES FUER DIAMANTPRODUKTE M [DE]; MANUF ET FABRIQUE DE MONTRES E [C] 6 octobre 2010 (2010-10-06) * alinéas [0005], [0008], [0027], [0030], [0031] *</p>
<p>A</p>	<p>EP 1 837 721 A1 (ETA SA MFT HORLOGERE SUISSE [CH]) 26 septembre 2007 (2007-09-26) * abrégé * * alinéa [0002] ~ alinéa [0005] *</p>
	<p>no. des revendications visées</p>
	<p>1-8, 10, 12-16</p>
	<p>1, 12</p>
	<p>-/--</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents</p>	
<p><input checked="" type="checkbox"/> Les documents de familles découvertes sont indiqués en annexe</p>	
<p>* Catégories spéciales de documents cités:</p>	
<p>*A* document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent</p>	<p>*T* document ultérieur publié après la date de dépôt ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la thèse constituant la base de l'invention</p>
<p>*E* document antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date</p>	<p>*X* document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément</p>
<p>*L* document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou être pertinent pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)</p>	<p>*Y* document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier</p>
<p>*C* document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens</p>	<p>*S* document qui fait partie de la même famille de brevets</p>
<p>*P* document publié avant la date de dépôt, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée</p>	
<p>Date à laquelle la recherche de type international a été effectivement achevée</p>	<p>Date d'expédition du rapport de recherche de type international</p>
<p>26 avril 2012</p>	
<p>Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.O. 5318 Patonilasan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040 Fax: (+31-70) 340-3016</p>	<p>Fonctionnaire autorisé Meister, Martin</p>

I

RAPPORT DE RECHERCHE DE TYPE INTERNATIONAL

Demande de recherche No

CH 17652011

C. (AUS) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		
Catégorie *	Documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	<p>EP 0 732 635 A1 (SUISSE ELECTRONIQUE MICROTECH [CH]) 18 septembre 1996 (1996-09-18) * abrégé * * colonne 6, ligne 1 - ligne 43 * * colonne 8, ligne 8 - ligne 43 *</p>	1,12
A	<p>US 6 080 445 A (SUGIYAMA OSAMU [JP] ET AL) 27 juin 2000 (2000-06-27) * figure 1 * * abrégé * * colonne 1, ligne 42 - ligne 65 * * colonne 5, ligne 29 - ligne 63 *</p>	1,12

1

RAPPORT DE RECHERCHE DE TYPE INTERNATIONAL

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Demande de recherche n°
CH 17652611

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
EP 2236455	A1	06-10-2010	AUCUN
EP 1837721	A1	26-09-2007	CN 101042570 A EP 1837721 A1 26-09-2007
EP 0732635	A1	18-09-1996	DE 69608724 D1 13-07-2000 DE 69608724 T2 08-02-2001 EP 0732635 A1 18-09-1996 FR 2731715 A1 20-09-1996
US 6080445	A	27-06-2000	AUCUN